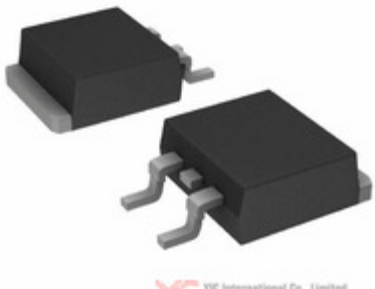









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB65R065C7ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB65R065C7ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB65R065C7ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 200µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263
Serie	CoolMOS™ P6
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 2.4A, 10V
Verlustleistung (max)	171W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Snap Clips
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	557pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.3A (Tc)

IPB65R065C7ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB65R065C7ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB65R065C7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB65R065C7ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB65R099C6 INFINEON IPB65R099C6 INFINEON</p>	 <p>IPB65R099C6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 38A TO263</p>	 <p>IPB65R045C7ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 46A TO-263-3</p>	 <p>IPB65R065C7ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>
 <p>IPB65R045C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 46A TO-263-3</p>	 <p>IPB65R095C7ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB65R095C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB60R950C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 4.4A TO263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB65R065C7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB65R065C7ATMA1 Datenblatt	IPB65R065C7ATMA1-Datenblätter	IPB65R065C7ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB65R065C7ATMA1
IPB65R065C7ATMA1 Electronic	IPB65R065C7ATMA1-Komponenten	IPB65R065C7ATMA1-Verteiler	IPB65R065C7ATMA1-Bild	IPB65R065C7ATMA1-Teil
IPB65R065C7ATMA1 Preis	IPB65R065C7ATMA1 Hersteller	IPB65R065C7ATMA1 Bild	IPB65R065C7ATMA1 Aktie	IPB65R065C7ATMA1 Inventar
IPB65R065C7ATMA1 Neu	IPB65R065C7ATMA1 Original	IPB65R065C7ATMA1 garantiert	IPB65R065C7ATMA1 RFQ	IPB65R065C7ATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited